# 3. 2000 年度 共同・プロジェクト研究報告

## レーダ散乱量を用いた散乱体の形状認識について

研究代表者	研究員	白井	<b>宏</b> (中央大学理工学部電気電子情報通信工学科)
共同研究者	研究員	趙	<b>晋輝</b> (中央大学理工学部電気電子情報通信工学科)
共同研究者	研究員	牧野	<b>光則</b> (中央大学理工学部情報工学科)

#### 1 はじめに

電磁波が物体に入射して散乱を起こすとき,その物体が 波長に比べて大きいほど,物体の局所的形状がその散乱パ ターンに大きく影響を及ぼす。したがって高周波電磁波を 用いた物体の散乱現象を調べるには,その散乱体の局所的 な形状をよく知る必要がある。逆に局所的な形状からの散 乱現象をある程度把握しておけば,その散乱データを基に 散乱体の形状の推定が可能となる。

筆者らは既に,自動車形状をモデルにした電磁波散乱解 析を行い,波長に比べ十分大きな散乱体の場合,幾何光学的 回折理論(Geometrical Theory of Diffraction: GTD[1]) に代表される高周波散乱解析手法は解析に十分有効である こと,また後方散乱については,主反射方向をもつ平板の 両端のエッジで励振されるエッジ回折波が重要な役割を果 たすことを示してきた[2]-[4]。そこで本報告では,凸型柱 状散乱体に平面電磁波が入射した場合の散乱現象をGTD を用いて解析し,主反射方向となる反射境界における回折 波の表現を基にして,後方散乱波の性質を調べた。そして 後方散乱に対して計算したモノスタティックレーダ散乱断 面積(Radar Cross Section: RCS)の角度依存性からその 散乱体を構成している各平板の大きさを簡単に推定する方 法を示す。

本報告で提案したアルゴリズムの有効性を調べるために, アルミ平板を用いて作られた導体散乱体モデルを使って, RCS 値を実測し,それらのデータに対し本アルゴリズム の適用を試みた。その結果,本方法は凸型柱状の散乱体に 対し,構成要素である各平板の寸法を精度よく推定できる ことが示された。さらに各平板を接続して元の散乱体の形 状を再構成し,可視化する方法についても調べている。

### 2 問題の定式化

#### 2.1 凸型柱状散乱体の RCS 値

完全導体の方形平板を組み合わせて作った凸型断面を持 つ柱状散乱体を考え,その RCS 値を求める。図1に示す ように入射角  $\theta_0$  で入射した H 偏波  $(u^i = H_z)$ の平面波:

$$u^{i} = \exp(-ikx\cos\theta_{0} - iky\sin\theta_{0}) \tag{1}$$

による散乱を考える。散乱体が凸型断面を持つ柱状導体 であるとすれば,散乱体から十分離れた観測点 P におけ る遠方放射界は,散乱体のエッジによって励振されるエッ ジ回折波のたし合わせで表すことができる。今,モノスタ ティック RCS 値から形状推定を行うことを念頭におくと, 凸型断面物体による高周波散乱については,主反射方向に 近い位置関係をもつ導体板の両エッジからのエッジ回折波 が主な寄与となることがわかっている [2],[3]。そこで図 1 のエッジ A, B からのエッジ回折波の寄与を GTD を用い て表すと [1]

$$u^t = u_A + u_B, \tag{2}$$

$$u_A = C(k\rho_A)D_{+1}(\theta_A, \theta_0, \phi_A)e^{i(ka/2)\cos\theta_0},$$
(3)

$$u_B = C(k\rho_B)D_{+1}(\theta_B, \pi - \theta_0, \phi_B)e^{-i(ka/2)\cos\theta_0}$$
(4)

と表される。ここで C(x) は,二次元自由空間の Green 関数の遠方界を,また  $D_{\tau}(\phi,\phi_0,\phi_w)$  は開き角  $\phi_w$  の導体エッジによる回折係数を表し

$$C(x) = \frac{1}{\sqrt{8\pi x}} e^{i(x+\pi/4)}, \qquad (5)$$
$$D_{\tau}(\phi, \phi_0, \phi_{\omega}) = \frac{2\pi}{\phi_{\omega}} \sin \frac{\pi^2}{\phi_{\omega}}$$
$$\cdot \left(\frac{1}{\cos \frac{\pi^2}{\phi_{\omega}} - \cos \frac{(\phi-\phi_0)\pi}{\phi_{\omega}}} + \frac{\tau}{\cos \frac{\pi^2}{\phi_{\omega}} - \cos \frac{(\phi+\phi_0)\pi}{\phi_{\omega}}}\right) (6)$$

と表される。ただし  $(\rho_A, \theta_A), (\rho_B, \theta_B)$  は, それぞれエッジ A, B を中心とした円筒座標である。

主反射方向への散乱遠方界は $\rho_{A,B} = \rho \pm (a/2) \cos \theta, \theta = \theta_A = \theta_B = \pi - \theta_0$ とおくことにより

$$u^{t} \sim C(k\rho) \left\{ -2ika\sin\theta_{0} + \frac{\frac{2\pi}{\phi_{A}}\sin\frac{\pi^{2}}{\phi_{A}}}{\cos\frac{\pi^{2}}{\phi_{A}}\left(1-\cos\frac{2\theta_{0}\pi}{\phi_{B}}\right) - \sin\frac{\pi^{2}}{\phi_{A}}\sin\frac{2\theta_{0}\pi}{\phi_{A}}} + \frac{\frac{2\pi}{\phi_{B}}\sin\frac{\pi^{2}}{\phi_{B}}}{\cos\frac{\pi^{2}}{\phi_{B}}\left(1-\cos\frac{2\theta_{0}\pi}{\phi_{B}}\right) - \sin\frac{\pi^{2}}{\phi_{B}}\sin\frac{2\theta_{0}\pi}{\phi_{B}}} \right\}$$
$$= -2ika\sin\theta_{0}C(k\rho) \left\{ 1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{ka}\right) \right\}$$
(7)



図<br />
1 導体平板による散乱

となる。この式から,明らかに ka が大きければエッジ A, B をもつそれぞれのウェッジの開き角  $\phi_A, \phi_B$  の影響は小 さくなることがわかる。したがって, z 方向に L の長さを もつ有限長角柱のうち,エッジ A, B を含む面からのモノ スタティック RCS 値は,  $\theta_0 = \pi/2$  とおいて

$$\overline{\sigma_{2D}} \sim \lim_{\rho \to \infty} 2\pi \rho \left| \frac{u^t}{u^i} \right|^2 = \frac{2\pi}{\lambda} a^2 \tag{8}$$

$$\overline{\sigma_{3D}} = \frac{2L^2}{\lambda} \sigma_{2D} = 4\pi \left(\frac{aL}{\lambda}\right)^2 \tag{9}$$

と近似することができる。ここで二次元 RCS 値  $\overline{\sigma_{2D}}$  から 対応する垂直入射の三次元 RCS 値  $\overline{\sigma_{3D}}$  への変換には変換 公式を用いた [5]。

いま平板の寸法 a, L のそれぞれを求めるには,上式で 求めた RCS のピーク値  $\overline{\sigma_{3D}}$  のみでは不可能である。そ こでピーク値を与える直近のゼロ点に注目した。両エッジ A, B からの回折係数が反射に対する影との境界前後で異 なる符合をもつことを考えると,反射境界前後のゼロ点は, エッジ A, B からの回折波の位相差が  $2\pi$  ずれたときに生 じる。つまり観測点 P からエッジ A, B 迄の距離  $\rho_A, \rho_B$ の差が往復で  $\pm \lambda$  のときである。散乱界を  $\theta_0 + \Delta \theta$  と考え ると,  $\Delta \theta$  と波長  $\lambda$  の間に

$$\lambda = |2a\cos(\theta_0 + \Delta\theta)| \tag{10}$$

なる関係が存在することがわかる。今  $heta_0 = \pi/2$  である から

$$a = \frac{\lambda}{2\sin\Delta\theta} = \frac{\pi}{k\sin\Delta\theta} \tag{11}$$

となり , この a の値と式 (9) の RCS ピーク値  $\overline{\sigma_{3D}}$  から

$$L = \sqrt{\frac{\lambda^2 \overline{\sigma_{3D}}}{4\pi a^2}} = \frac{\sqrt{\overline{\sigma_{3D}}\pi}}{ka} \tag{12}$$

が求められる。



#### 2.2 形状の認識アルゴリズム

前節のようにして,散乱体の構成要素となっている導体 平板の大きさを求める。最初に問題となるのは,測定した RCS データの中から,平板の主反射方向を示すピーク値 を検索することである。散乱体が,ほぼ180°に近い開き 角のウェッジで近似されると,両面の主反射方向が近くな るので誤認識につながる。ここでは,各RCS値のうち極 大値を結んでできた線分から,再び代表的な極大値を抽出 し,その点の前後のゼロ点を用いた。さらに測定点の少な い場合には,測定点の値が極大,あるいは極小とならない こともある。したがって,データ補間が必要となる[6]。

#### 3 結果及び検討考察

#### 3.1 凸型散乱体の認識

今回の認識アルゴリズムの有効性を示すために,散乱体 モデルを作り,電波暗室内の測定値をもとに,認識を行っ た。図 2,3 に使用した凸型柱状散乱体を示す。図 2 は 4 角柱,図 3 は 6 角柱のモデルであり,厚さ 5mm のアルミ 平板を接続して作られている。各モデルの主要寸法はそれ ぞれ a=143mm, b=40mm, c=57mm, d=24mm である。

これらのモデルに対する RCS 測定値を図4,図5に示 す。ここで測定に用いられた周波数は24GHz である。

測定結果の図4,5から明らかなように,散乱体を構成し ている導体平板の幅a(このモデルでは,Lに相当する寸法 cは一定値(57mm)としている。)とそれらの数に対応し て鋭いピークがRCS値に存在することがわかる。測定デー タは0.5°ごとのサンプルであり,再構成のためにはRCS ピーク値の算出に近くのサンプリング値からスプライン補 間関数を用いて,4次のB-スプライン関数[7]で補間し決 定している。近くのエッジ間における多重散乱や測定実験



図 5 モデル 2 の散乱特性 (測定値)

の誤差の影響もあり,検出したピーク値の前後のゼロ点ま での角度  $\Delta \theta$  は対称にはならない。いろいろな検討の結果,  $\Delta \theta$  の値としてはピーク値前後のゼロ点までの角度  $\Delta \theta_+$ ,  $\Delta \theta_-$ を抽出し,それらの平均値  $\Delta \theta (= (\Delta \theta_+ + \Delta \theta_-)/2)$ で決定したほうがよいことがわかっており,その方法をこ こで用いている。

このようにして求めた主反射の角度,各平板の大きさを 表1,表2に示す。最大の推定誤差は4.9mm で14.4%と なり,両モデルとも非常に真値に近い推定が行えることが わかる。特に軸長 L の誤差については,幅aのそれに比 べやや大きくなっているが,これは $\Delta \theta$ からaを推定し, その値と RCS ピーク値 $\overline{\sigma_{3D}}$ を用いて Lを推定するため aの誤差まで含まれるためと考えられる。

#### 3.2 散乱体の再構成と可視化

こうして得られた各平板の大きさ,方向だけでは散乱体 の全体形状は推定されていないので,どんな形状をしてい るかわかりにくい。そこでこれらのデータを基にして,散 乱体の形状の再構成を試みる。

形状の再構成にもいろいろな方法が考えられるが,ここ

主反射角 [ °]		平板の	幅 a[mm]	平板の軸長 <i>L</i> [mm]				
真値	推定値	真値	推定値	真値	推定値			
-90.0	-89.9	143.0	143.3	57.0	55.6			
			(0.21%)		(2.46%)			
36.0	34.5	52.0	51.3	57.0	58.2			
			(1.35%)		(2.11%)			
90.0	90.9	60.0	62.3	57.0	50.8			
			(3.83%)		(10.9%)			
130.0	129.6	65.0	65.2	57.0	60.5			
			(0.31%)		(6.14%)			
(カッコ内は真値に対する誤差 [%]を表す)								

表1 認識後のモデル1の面の大きさの比較

主反射角[。]		平板の	幅 a[mm]	平板の軸長 <i>L</i> [mm]	
真値	推定値	真値	推定値	真値	推定値
-90.0	-89.8	143.0	143.3	57.0	56.4
			(0.21%)		(1.05%)
0.0	1.5	28.0	29.5	57.0	53.6
			(5.36%)		(5.96%)
64.0	63.6	34.0	38.9	57.0	56.8
			(14.4%)		(3.33%)
90.0	90.5	58.5	62.4	57.0	56.8
			(6.67%)		(0.35%)
106.0	105.8	54.0	53.2	57.0	57.3
			(1.48%)		(0.53%)
180.0	179.6	28.0	28.9	57.0	58.7
			(3.21%)		(2.98%)

(カッコ内は真値に対する誤差 [%] を表す)

表 2 認識後のモデル 2 の面の大きさの比較

では全ての平板の主反射の角度を用いて面と面を接続する 方法を用いた。図6,図7にその結果を示す。各図の右側 が断面形状,左側が三次元的な構成図である。接続したこ とにより最初の面と最後の面の接続部分(図中の左下)に 誤差が集積することになる。これらの可視化した再構成図 は,Java 言語を用いたプログラムにより,パーソナルコ ンピュータの画面上に,標準的なブラウザである Internet Explorer 等を用いて表示できる。また,マウスで様々な視 点から観測できるように操作することができる[8]。

#### 4 結論

本報告では,モノスタティック RCS 値を用いて凸型柱 状散乱体の形状認識のためのアルゴリズムを考案した.多 角柱形状をもつ導体散乱体の後方散乱のようすを高周波 漸近解法である GTD を用いて解析し,ここで用いたアル ゴリズムは実際に電波暗室内のモデル物体によるモノスタ ティック RCS 測定結果に対して適用し,その有効性を調 べた。その結果,本アルゴリズムは凸型柱状物体の各平板 の大きさを推定するのに有効であることが示された。さら にこうして得られた各平板の大きさを基に散乱体の形状を 再構成し,可視化する方法においても検討した。今後は, 凹部をもつことにより主反射方向が逆転したり,二枚以上 の板が平行に存在,あるいはほとんど平行に存在する場合



図 6 RCS 実験値からの再構成図(モデル1)



図 7 RCS 実験値からの再構成図(モデル2)

について,それらを分離する方法について検討を進める方 針である。

#### 謝辞

本研究は,中央大学理工学研究所 2000 年度,2001 年 度共同研究の援助を受けて行われた。ここに記し,謝意を 表する。

#### 参考文献

- J. B. Keller: "Geometrical theory of diffraction," J. Opt. Soc. Am., 52(2), pp.116-130, 1962.
- [2] 林,白井,関口: "多角柱による平面電磁波の散乱解 析,"電学会電磁界理論研資,EMT-97(36),pp.61-66, 1997.
- [3] 白井,林:"自動車モデルに対する電磁波の散乱,"電
   学会電磁界理論研資, EMT-99(78), pp.47-52, 1999.
- [4] H. Shirai, K. Okawa and T. Hayashi: "High frequency EM scattering by automobile models," Proc. of 2001 Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2001), p.124, 2001.
- [5] R. A. Ross: "Radar cross section of rectangular flat plates as a function of aspect angle," *IEEE Trans. Antennas and Propag.*, AP-14(3), pp.329-335, 1966.
- [6] 有竹: "RCS を用いた完全導体散乱体の形状推定,"卒業論文,中央大学理工学部,2000.

- [7] 桜井, 菅野, 吉村, 高山: "Cによるスプライン関数," 東京電機大学出版, 1993.
- [8] 小野,白井,有竹,牧野,趙: "RCS 値を用いた凸型 柱状散乱体の形状認識について,"電気学会電磁界理 論研資, EMT-01(96), 2001.